

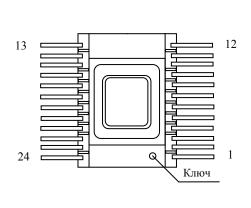
ЭТИКЕТКА

СЛКН.431323.006 ЭТ

Микросхема интегральная 564 ПУ9В Функциональное назначение — Двунаправленный 8-разрядный преобразователь уровня

Схема расположения выводов

Условное графическое обозначение



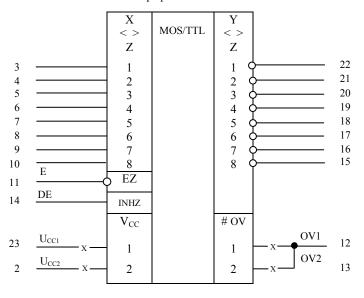


Таблица назначения выводов

| № вывода | Обозначение вывода | Назначение вывода | № вывода | Обозначение вывода | Назначение вывода | |
|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|--|
| 1 | - | Свободный | 13 | OV2 | Общий 2 | |
| 2 | U_{CC2} | Питание 2 | 14 | DE | Вход «запрет» | |
| 3 | X1 | Первый канал КМДП | 15 | Y8 | Восьмой канал ТТЛ | |
| 4 | X2 | Второй канал КМДП | 16 | Y7 | Седьмой канал ТТЛ | |
| 5 | X3 | Третий канал КМДП | 17 | Y6 | Шестой канал ТТЛ | |
| 6 | X4 | Четвертый канал КМДП | 18 | Y5 | Пятый канал ТТЛ | |
| 7 | X5 | Пятый канал КМДП | 19 | Y4 | Четвертый канал ТТЛ | |
| 8 | X6 | Шестой канал КМДП | 20 | Y3 | Третий канал ТТЛ | |
| 9 | X7 | Седьмой канал КМДП | 21 | Y2 | Второй канал ТТЛ | |
| 10 | X8 | Восьмой канал КМДП | 22 | Y1 | Первый канал ТТЛ | |
| 11 | E | Вход «разрешение» | 23 | U _{CC1} | Питание 1 | |
| 12 | OV1 | Общий 1 | 24 | - | Свободный | |

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при $t = (25\pm10)$ °C)

Таблица 1

| Цантионарация нараметра, отнична намарания, раздим намарания | Буквенное | Норма | |
|---|--------------------|----------|----------|
| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | обозначение | не менее | не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Выходное напряжение низкого уровня, В, при: | | | |
| $U_{CC1} = U_{CC2} = 4 B$; $U_{IL} = 0 B$; $U_{IH} = U_{CC1}$ | ** | | 0.5 |
| для выходов КМДП | U_{OL1} | - | 0,5 |
| для выходов ТТЛ | U_{OL2} | - | 0,5 |
| 2. Выходное напряжение высокого уровня, В, при: | | | |
| $U_{CC1} = U_{CC2} = 4 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC1}$ | | | |
| для выходов КМДП | U_{OH1} | 3,5 | - |
| для выходов ТТЛ | U_{OH2} | 3,5 | - |
| 3. Входной ток низкого и высокого уровня, мкА, для входов КМДП при: | $I_{\rm IL1},$ | | 1,0 |
| $U_{CC2} = 12,6 \text{ B}; U_{CC1} = 5 \text{ B}; U_{IL} = 0 \text{ B}; U_{IH} = U_{CC2}$ | I_{IH1} | - | 1,0 |
| 4. Входной ток низкого уровня, мкА, для входов ТТЛ, выводов «разрешение», | 1 | | / 1 0/ |
| «запрет» при: U _{CC2} =12,6 B; U _{CL1} =5 B; U _{IL} = 0 B | I_{IL2} | - | /-1,0/ |

| Продолжение таблицы 1 | | | |
|--|--|----------|------------|
| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | Буквенное | Норма | |
| | обозначение | не менее | не более |
| 5. Входной ток высокого уровня, мкА, для входов ТТЛ, выводов «разрешение», «запрет» при: $U_{CC2} = 12,6$ В; $U_{CC1} = 5$ В | 2 | 3 | 1,0 |
| $U_{1H2} = 5 \text{ B}$ $U_{1H2} = 12,6 \text{ B}$ | I_{IH2} I_{IH3} | - | 1,0 |
| 6. Выходной ток низкого уровня, мА, для выходов КМДП при: $U_{CC2}=12,0~B;~U_{CC1}=5,0~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=2,3~B;~U_{O}=0,5~B$ | I _{OL1} | 3,0 | - |
| 7. Выходной ток высокого уровня, мА, для выходов КМДП при: $U_{\rm CC2}=12,0~{\rm B};~U_{\rm CC1}=5,0~{\rm B};~U_{\rm IL}=0,7~{\rm B};~U_{\rm IH}=5,0~{\rm B};~U_{\rm O}=11,5~{\rm B}$ | І _{оні} | /-3,0/ | - |
| 8. Выходной ток низкого уровня, мА, для выходов ТТЛ при: $U_{CC2}=12,0~B;~U_{CC1}=5,0~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=10~B;~U_{O}=0,4~B$ | I_{OL2} | 6,8 | - |
| 9. Выходной ток высокого уровня, мА, для выходов ТТЛ при: $U_{\rm CC2}=12,0~{\rm B};~U_{\rm CC1}=5,0~{\rm B};~U_{\rm IL}=2,0~{\rm B};~U_{\rm IH}=12,0{\rm B};~U_{\rm O}=3,0~{\rm B}$ | I_{OH2} | /-6,8/ | - |
| 10. Выходной ток в состоянии «выключено», мкА, для выходов КМДП, при: $U_{CC2}=12,6~B;~U_{CC1}=5,0~B;~U_{IL}=0B;~U_{IH}=12,6~B;~U_{E}=U_{DE}=0~B;~U_{O}=12,6~B$ | I_{OZ1} | - | 1,0 |
| 11. Выходной ток в состоянии «выключено», мкА, для выходов ТТЛ при: $U_{CC2}=12,6~B;~U_{CC1}=5,0~B;~U_{O}=5,0~B;~U_{IL}=0~B;~U_{E}=U_{DE}=12,6~B;~U_{O}=5,0~B$ | I_{OZ2} | <u>-</u> | 1,0 |
| $U_{IH 2} = 5.0 \text{ B}; U_E = U_{DE} = 12.6 \text{ B}; U_O = 0 \text{ B}$ | I _{OZ 3} | - | /-1,0/ |
| U_{IL} = 0 B; U_E = 0; U_{DE} = 12,6 B; U_O = 0 B и 5,0 B; $U_{IH 2}$ = 5,0 B | I _{OZ 4} | - | 1,0 |
| 12. Ток потребления (от источника питания U_{CC2}), мА, при: $U_{CC1} = U_{CC2} = 12,6$ В; $U_{IL} = 0$ В; $U_{IH} = 12,6$ В; $U_E = U_{DE} = 0$ В $U_E = U_{DE} = U_{CC2}$; уровни ТТЛ = U_{CC2} | I _{CC 2} | - | 1,5 5,0 |
| 13. Ток потребления (от источника питания U_{CC1}), мкА, при: $U_{CC1}=U_{CC2}=12,6~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=12,6~B$ | I _{CC 1} | - | 20 |
| 14 . Время задержки распространения при включении и выключении от входов КМДП к выходам ТТЛ, нС, при: $U_{CC2}=12~B;~U_{CC1}=5~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=12~B;~U_{E}=U_{DE}=0~B~C_{L}=50~\pi\Phi$ $C_{L}=50~\pi\Phi$ | t _{PHL 1} , t _{PLH 1} | - | 110 150 |
| _ | | = | 150 |
| 15. Время задержки распространения при включении и выключении от входов ТТЛ к выходам КМДП, нС, при: $U_{CC2}=12~B;~U_{CC1}=5~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=5~B;$ $U_E=U_{DE}=5,0~B$ $C_L=50~\pi\Phi$ $C_L=200~\pi\Phi$ | t _{PHL 2} , t _{PLH 2} | - | 160 200 |
| 16. Время задержки распространения от входа «разрешение» к выходам КМДП, нС, при: $U_{CC2}=12~B;~U_{CC1}=5~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=5~B~(уровни~TTЛ); \\U_{IH}=12~B~(уровни~KМДП);~C_L=50~п\Phi;~C_L=200~п\Phi$ | t _{PZH 1} , t _{PZL 1} , t _{PHZ 1} , t _{PLZ 1} | - | 200 |
| 17. Время задержки распространения от входа «запрет» к выходам ТТЛ, нС, при: $U_{CC2}=12~B;~U_{CC1}=5~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=5~B~(уровни ТТЛ);~U_{IH}=12~B~(уровни КМДП);~C_L=50~п\Phi;~C_L=200~п\Phi$ | $t_{PZH2},\\t_{PZL2},\\t_{PHZ2},\\t_{PLZ2}$ | - | 200 |
| 18. Время перехода при включении и выключении для выходов КМДП, нС, при: $U_{CC2}=12~B;~U_{CC1}=5~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=5~B;~U_{E}=U_{DE}=12~B~C_{L}=50~\pi\Phi~C_{L}=200~\pi\Phi$ | t _{THL 1} , t _{TLH 1} | - | 130 240 |
| 19. Время перехода при включении и выключении для выходов ТТЛ, нС, при: $U_{CC2}=12~B;~U_{CC1}=5~B;~U_{IL}=0~B;~U_{IH}=12~B;~U_{E}=0~B~u~12~B;~U_{DE}=0~B~C_{L}=50~\pi\Phi$ $C_{L}=200~\pi\Phi$ | t _{THL 2} , t _{TLH 2} | - | 110 |
| C _L - 200 IIΨ | | - | 200 |

| | золото | Γ, |
|-------------------------|---|--|
| | серебро | Γ, |
| в том чис | еле: | |
| | золото | г/мм |
| на 24 вы | водах, длиной | MM. |
| Цветных | металлов не содержится. | |
| 2 НАДЕЖ | КНОСТЬ | |
| 2.1 Мини | мальная наработка (Тнм) микросхе | ем в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых стандартом ОСТ В 11 0398 – 2000 и ТУ, при |
| температуре окр | ружающей среды (температуре эксі | плуатации) не более 65 $^{\circ}$ C не менее 100000 ч., а в облегченных режимах, которые приводят в ТУ |
| при $U_{CC} = 5B \pm 1$ | 10% - не менее 120000 ч. | |
| Гамма – г | процентный ресурс (Тру) микросхе | м устанавливают в ТУ при γ = 95% и приводят в разделе " Справочные данные" ТУ. |
| 2.2 Миним | мальный срок сохраняемости микр | осхем (T_{cm}) при их хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми влажностью и |
| | ли местах хранения микросхем, вм | юнтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 2 |
| лет. | ьный спок соупандемости микпосу | ем в условиях, отличающихся от указанных,- в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0398 – 2000. |
| | | зготовления, указанной на микросхеме. |
| 2515111 | | NAME TO |
| | ТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВ гии предприятия – изготовителя – 1 | |
| • | | |
| | | гветствие поставляемой микросхемы всем требованиям ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной |
| | | блюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также |
| указаний по при | менению, установленных ТУ. | |
| Срок гара | антии исчисляют с даты изготовлен | ия, нанесенной на микросхеме. |
| 4 СВЕДЕ | НИЯ О ПРИЕМКЕ | |
| Микросхе | емы 564 ПУ9В соответствуют техні | ическим условиям бК0.347.064 – 36 ТУ/02 и признаны годными для эксплуатации. |
| Приняты | по от | |
| | (извещение, акт и др.) | (дата) |
| Место для | я штампа ОТК | Место для штампа ВП |
| | | |
| Место для | я штампа «Перепроверка произве; | дена» |
| | | |
| Приняты | по от | (дата) |
| | 0.0004 | |
| Место дл | я штампа ОТК | Место для штампа ВП |
| | | |
| <u>Цена дог</u> | <u>говорная</u> | |
| 5 VV A 2 A | .НИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКС | ППУАТАНИИ |
| 3 ynasa | аныя по на именелию и ЭКС. | UNIVATAQUII |

5.1 При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 500 В. Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общая точка, выход – общая точка.

Остальные указания по применению и эксплуатации – в соответствии с бК0.347.064 ТУ/02.

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем: